

# 198НТ1Б, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на [sales@iElekt.ru](mailto:sales@iElekt.ru) или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

## 198НТ1Б микросхемы полупроводниковой:

198НТ1Б — цифровая микросхема являются транзисторной логикой с функционалом матрицы транзисторов NPN типаи используются в РЭА в большой области эксплуатации. Производятся в керамометаллическом корпусе 401.14-5. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям ШПО.348,002ТУ.

## Ссылки на технические материалы

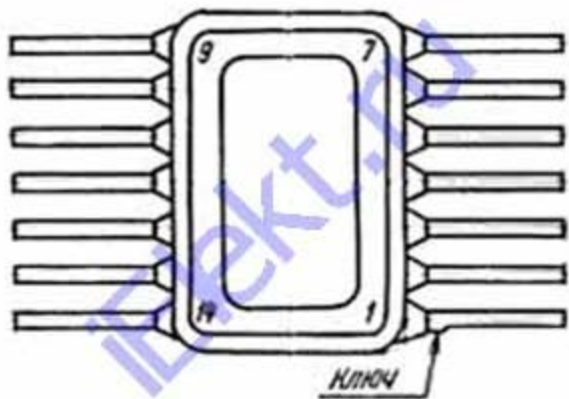
ссылки на 198НТ1Б дополнительный материал:

<a href="#">карта</a>	<a href="#">фото ТИП1, ТИП2</a>	<a href="#">схема выводов ТИП1, ТИП2</a>
<a href="#">значение выводов</a>	<a href="#">параметры</a>	<a href="#">предельные параметры</a>
<a href="#">эксплуатация</a>	<a href="#">PDF</a>	

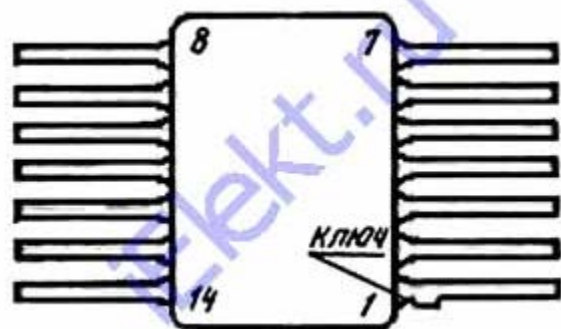
## Знак завода изготовителя



## Расположения выводов схематическое

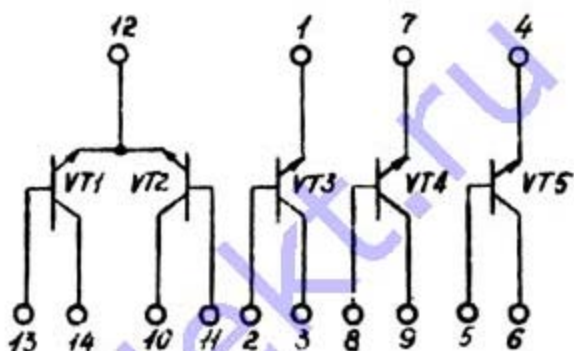


ТИП1 вес не превышает 0,5г.



ТИП2 вес не превышает 0,6г.

## Схема электрическая принципиальная для НТ1



Для 198НТ2 - без транзистора VT4

Для 198НТ3 - без транзистора VT1

Для НТ2 - без транзистора VT4

Для НТ3 - без транзистора VT1

## Основные электрические параметры при $t=25 \pm 10$ градусов Цельсия

таблица основных 198НТ1Б электро показателей:

Название характеристики, единица и режим замера	Буквенное обозначение	Допуск							
		НТ1А, НТ2А		НТ1Б, НТ2Б		НТ1В		НТ3	
		больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше
Статический коэффициент передачи тока									

транзистора (при $U_{кб}=3V$ ; $I_{э}=0,5mA$ ; для НТ1В $I_{э}=0,05mA$ )	h21э	30	200	30	200	50	150	30	200
Обратный ток коллектора, $\mu A$ (при $U_{кб}=6V$ )	ИКБО	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05
Напряжение насыщения база-эмиттер, $V$ (при $I_{к}=3mA$ , $I_{б}=0,5mA$ )	U БЭнас	-	0,8	-	0,8	-	0,8	-	0,8
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, $V$ (при $I_{к}=3mA$ , $I_{б}=0,5mA$ )	U КЭнас	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,2
Разброс статических коэффициентов передачи тока транзисторов дифференциальной пары, % (при $U_{кб}=3V$ ; $I_{э}=0,5mA$ ; для НТ1В $I_{э}=0,05mA$ )	Sh21Э	-	15	-	15	-	15	-	15
Разброс напряжения между базой и эмиттером транзисторов дифференциальной пары, $mV$ (при $\sum I_{э}=0,5mA$ , $U_{кб}=3V$ )	бУБЭ	-	3	-	10	-	3	-	-

## Предельные 198НТ1Б параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.